

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

H01L 29/78

H01L 21/336

[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 01145774.0

[43] 公开日 2002 年 8 月 28 日

[11] 公开号 CN 1366350A

[22] 申请日 2001.12.26 [21] 申请号 01145774.0

[30] 优先权

[32] 2000.12.26 [33] JP [31] 395726/2000

[32] 2001.11.22 [33] JP [31] 358332/2001

[1] 申请人 株式会社东芝

地址 日本东京都

[72] 发明人 篠智彰

[74] 专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

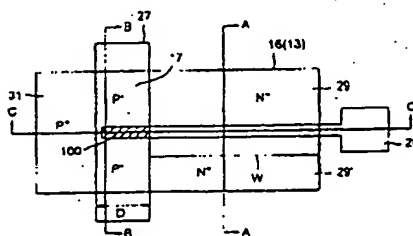
代理人 王永刚

权利要求书 4 页 说明书 13 页 附图页数 21 页

[54] 发明名称 半导体器件及其制造方法

[57] 摘要

半导体器件包括:器件区域内形成的第 1 导电类型的半导体层;上述半导体层上介以栅绝缘膜选择地形成的第 1 栅电极;至少在上述第 1 栅电极的一部分和上述半导体层的一部分上形成的第 1 绝缘膜掩模;以及在未被上述第 1 绝缘膜掩模和第 1 栅电极覆盖的上述器件区域内邻接上述第 1 栅电极形成的,作为源区或漏区使用的第 2 导电类型的一对第 1 扩散区。



ISSN 1008-4274